

**Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования
«Московский физико-технический институт
(национальный исследовательский университет)»**

УТВЕРЖДЕНО

**Директор физтех-школы
электроники, фотоники и
молекулярной физики**

В.В. Иванов

| | |
|----------------------------|---|
| | Рабочая программа дисциплины (модуля) |
| по дисциплине: | Интеграция технологических процессов микро и наноэлектроники |
| по направлению: | Прикладные математика и физика |
| профиль подготовки: | Физика перспективных технологий: электроника и квантовые технологии Физтех-школа Электроники, Фотоники и Молекулярной Физики кафедра микро- и наноэлектроники |
| курс: | 1 |
| квалификация: | магистр |

Семестр, формы промежуточной аттестации: 2 (весенний) - Экзамен

Аудиторных часов: 30 всего, в том числе:

лекции: 15 час.

семинары: 15 час.

лабораторные занятия: 0 час.

Самостоятельная работа: 30 час.

Подготовка к экзамену: 30 час.

Всего часов: 90, всего зач. ед.: 2

Программу составил: П.В. Игнатов

Программа обсуждена на заседании кафедры микро- и наноэлектроники 29.05.2020

Аннотация

Курс "Интеграция технологических процессов микро и нанoeлектроники" предусматривает формирование специальных знаний в области практической технологии микро-нанoeлектроники, о физических и химических основах проведения технологических и контрольно-измерительных операций в микро-нанoeлектронике, о физических и технических принципах конструктивного исполнения технологического оборудования используемого в микро-нанoeлектронике, о принципах разработки физической структуры изделий микро-нанoeлектроники и технологических процессах их изготовления.

Задачи курса:

- Рассмотрение физических и химических основ проведения технологических операций в микро и нанoeлектронике;
- Рассмотрение физических параметров определяющих условия проведения технологических операций в микро и нанoeлектронике;
- Рассмотрения влияния физических параметров технологических операций на параметры физической структуры изделий микро и нанoeлектроники при их изготовлении;
- Рассмотрение влияния параметров технологических операций на физические параметры изделий микро и нанoeлектроники;
- Рассмотрение принципов разработки режимов проведения технологических операций в микро и нанoeлектронике;
- Рассмотрение основных принципов разработки технологических процессов изготовления изделий микро и нанoeлектроники;
- Рассмотрение принципов построения основных видов технологического оборудования в практической микро и нанoeлектронике;
- Рассмотрение влияния параметров технологического оборудования на параметры физической структуры изделий микро и нанoeлектроники при их изготовлении в условиях технологической линии.

По результатам освоения курса студент должен:

Знать:

- Физические и химические основы технологических операций в микро и нанoeлектронике.
- Физические параметры характеризующие технологические операции.
- Технические и физические основы конструктивного исполнения технологического оборудования.
- Влияние физических параметров технологических операций на параметры физической структуры элементной базы и изделий в целом в микро и нанoeлектронике.

Уметь:

- Разрабатывать основные режимы технологических операций. Разрабатывать технологические процессы.
- Проводить анализ влияния физических параметров технологических операций на параметры физической структуры изделий микро и нанoeлектроники.
- Применять статистические методы анализа для оценки качества проведения технологических процессов.
- Планировать и проводить эксперименты при разработке технологических процессов микро и нанoeлектроники.

Владеть:

- Первичными навыками разработки технологических операций и технологических процессов микро и нанoeлектроники.
- Первичными навыками работы на технологическом оборудовании.
- Основными методами анализа оценки качества технологических операций и технологических процессов. Основными методами проведения экспериментов при разработке технологических процессов микро и нанoeлектроники.

Основное содержание курса изложено в следующих разделах:

1. Вводная лекция по курсу «Основы технологии микро и нанoeлектроники».
2. Процессы ЖХО в маршруте изготовления ИМС.
3. Различные стратегии проведения жидкостных очисток пластин и удаления конкретных загрязнений.
4. Удаление полимерных остатков после проведения процессов плазмохимического травления.
5. Обзор оборудования для процессов ЖХО.
6. Диэлектрические слои в технологии УБИС.
7. Физические основы оптической литографии.
8. Оптические проблемы проекционной литографии.
9. Формирование изображения в фоторезисте.
10. Фоторезисты.
11. Проявление фоторезистов.
12. Контроль и измерение параметров качества проявленного рельефа маски из фоторезиста.
13. Способы улучшения разрешающей способности процесса фотолитографии (RET).
14. Оборудование фотолитографии.
15. Техничео-экономические показатели фотолитографического оборудования и производства.
16. Особенности ионной имплантации и ее применение в технологии микроэлектроники.

1. Цели и задачи

Цель дисциплины

- формирование специальных знаний в области практической технологии микро-нанoeлектроники, о физических и химических основах проведения технологических и контрольно-измерительных операций в микро-нанoeлектронике, о физических и технических принципах конструктивного исполнения технологического оборудования используемого в микро-нанoeлектронике, о принципах разработки физической структуры изделий микро-нанoeлектроники и технологических процессах их изготовления.

Задачи дисциплины

- рассмотрение физических и химических основ проведения технологических операций в микро и нанoeлектронике;
- рассмотрение физических параметров определяющих условия проведения технологических операций в микро и нанoeлектронике;
- рассмотрение влияния физических параметров технологических операций на параметры физической структуры изделий микро и нанoeлектроники при их изготовлении;
- рассмотрение влияния параметров технологических операций на физические параметры изделий микро и нанoeлектроники;
- рассмотрение принципов разработки режимов проведения технологических операций в микро и нано электронике;
- рассмотрение основных принципов разработки технологических процессов изготовления изделий микро и нанoeлектроники;
- рассмотрение принципов построения основных видов технологического оборудования в практической микро и нанoeлектронике;
- рассмотрение влияния параметров технологического оборудования на параметры физической структуры изделий микро и нанoeлектроники при их изготовлении в условиях технологической линии.

2. Перечень формируемых компетенций

Освоение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:

| Код и наименование компетенции | Индикаторы достижения компетенции |
|---|---|
| ОПК-3 Способен выбирать и (или) разрабатывать подходы к решению типовых и новых задач в области профессиональной деятельности, учитывая особенности и ограничения различных методов решения | ОПК-3.3 Владеет аналитическими и вычислительными методами решения, понимает и учитывает на практике границы применимости получаемых решений |
| | ОПК-3.1 Способен анализировать задачу, планировать пути решения, предлагать и комбинировать способы решения |

| | |
|---|--|
| ПК-1 Способен ставить, формализовывать и решать задачи, в том числе разрабатывать и исследовать математические модели изучаемых явлений и процессов, системно анализировать научные проблемы, получать новые научные результаты | ПК-1.1 Способен находить, анализировать и обобщать информацию об актуальных результатах исследований в рамках тематической области своей профессиональной деятельности |
| | ПК-1.2 Способен выдвигать гипотезы, строить математические модели для описания изучаемых явлений и процессов, оценивать качество разработанной модели |
| | ПК-1.3 Способен применять теоретические и (или) экспериментальные методы исследований к конкретной научной задаче и интерпретировать полученные результаты |

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю)

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны

знать:

- физические и химические основы технологических операций в микро и нанoeлектронике;
- физические параметры характеризующие технологические операции;
- технические и физические основы конструктивного исполнения технологического оборудования;
- влияние физических параметров технологических операций на параметры физической структуры элементной базы и изделий в целом в микро и нанoeлектронике.

уметь:

- разрабатывать основные режимы технологических операций. Разрабатывать технологические процессы;
- проводить анализ влияния физических параметров технологических операций на параметры физической структуры изделий микро и нанoeлектроники;
- применять статистические методы анализа для оценки качества проведения технологических процессов;
- планировать и проводить эксперименты при разработке технологических процессов микро и нанoeлектроники.

владеть:

- первичными навыками разработки технологических операций и технологических процессов микро и нано электроники;
- первичными навыками работы на технологическом оборудовании;
- основными методами анализа оценки качества технологических операций и технологических процессов;
- основными методами проведения экспериментов при разработке технологических процессов микро и нанoeлектроники.

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкости по видам учебных занятий

| № | Тема (раздел) дисциплины | Трудоемкость по видам учебных занятий, включая самостоятельную работу, час. | | | |
|---|--|---|----------|-----------------|----------------|
| | | Лекции | Семинары | Лаборат. работы | Самост. работа |
| 1 | Вводная лекция по курсу «Основы технологии микро и нанoeлектроники». | 1 | 1 | | 2 |
| 2 | Процессы ЖХО в маршруте изготовления ИМС. | 1 | 1 | | |

| | | | | | |
|-----------------------|--|--------------------|----|--|----|
| 3 | Различные стратегии проведения жидкостных очисток пластин и удаления конкретных загрязнений. | 1 | 1 | | 4 |
| 4 | Удаление полимерных остатков после проведения процессов плазмохимического травления. | 1 | 1 | | 4 |
| 5 | Обзор оборудования для процессов ЖХО. | 1 | 1 | | |
| 6 | Диэлектрические слои в технологии УБИС. | 1 | 1 | | |
| 7 | Физические основы оптической литографии. | 1 | 1 | | 4 |
| 8 | Оптические проблемы проекционной литографии. | 1 | 1 | | |
| 9 | Формирование изображения в фоторезисте. | 1 | 1 | | |
| 10 | Фоторезисты. | 1 | 1 | | 4 |
| 11 | Проявление фоторезистов. | 1 | 1 | | 4 |
| 12 | Контроль и измерение параметров качества проявленного рельефа маски из фоторезиста. | 1 | 1 | | 2 |
| 13 | Способы улучшения разрешающей способности процесса фотолитографии (RET). | 1 | 1 | | |
| 14 | Оборудование фотолитографии. | 1 | 1 | | 2 |
| 15 | Технико-экономические показатели фотолитографического оборудования и производства. | | 1 | | 2 |
| 16 | Особенности ионной имплантации и ее применение в технологии микроэлектроники. | 1 | | | 2 |
| Итого часов | | 15 | 15 | | 30 |
| Подготовка к экзамену | | 30 час. | | | |
| Общая трудоёмкость | | 90 час., 2 зач.ед. | | | |

4.2. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам)

Семестр: 2 (Весенний)

1. Вводная лекция по курсу «Основы технологии микро и нанoeлектроники».

Основные технологические операции и их назначение в микро и нано электронике.

Базовый технологический процесс и его разновидности в микро и нанoeлектронике.

Основные принципы разработки базового технологического процесса в микро и нанoeлектронике. Чистые производственные помещения. Основные принципы разработки среды проектирования в микро и нанoeлектронике.

2. Процессы ЖХО в маршруте изготовления ИМС.

Влияние уровня интеграции на количество жидкостных химических обработок по маршруту. Распределение общего количества процессов жидкостных химических обработок по функциональному назначению. Источники и природа загрязнения кремниевых пластин и методы подготовки поверхности. Микрочастицы: механизмы осаждения микрочастиц в воздушных и жидких средах. Металлы: классификация, влияние на выходные характеристики изготавливаемых приборов, методы анализа. Органические загрязнения: влияние на измеряемые параметры изготавливаемых изделий, влияние на состояние поверхности, влияние на рост слоёв при химическом осаждении из газовой фазы.

3. Различные стратегии проведения жидкостных очисток пластин и удаления конкретных загрязнений.

Основные способы удаления микрочастиц, металлических и органических загрязнений. Общая последовательность процесса жидкостной очистки. Процессы жидкостного химического травления кремниевых пластин. Контроль качества (по остаточной толщине слоя, по линейным размерам, визуальный контроль). Основные характеристики процесса травления. Сравнение процессов жидкостного и плазмохимического травления.

4. Удаление полимерных остатков после проведения процессов плазмохимического травления.

Визуальный контроль с помощью оптических методов. Коррозионные циклы. Особенности процессов удаления полимерных остатков в цикле формирования транзисторной структуры. Особенности удаления полимерных остатков в цикле металлизации (Al). Удаление микрочастиц и процессы очистки без использования химических реактивов. Назначение процессов гидромеханической очистки. Различные технологии проведения гидромеханической очистки: обработка струёй, обработка с помощью мегазвуковой энергии, очистка с использованием щёток, очистка с помощью распыления.

5. Обзор оборудования для процессов ЖХО.

Принципы работы ванны с рециркуляцией химреактива. Принципы работы промывных ванн. Техника безопасности и охрана труда при проведении ЖХО. Совместимость применяемых химических реактивов и потенциальные риски смешивания. Количество потребляемых жидких химических реактивов в современном микроэлектронном производстве. Экскурсия в ЧПП для ознакомления с оборудованием ЖХО.

6. Диэлектрические слои в технологии УБИС.

Применение и функции различных диэлектрических слоев в физической структуре кристаллов УБИС. Физико-химические основы процессов, модели формирования и основные характеристики диэлектрических слоев. Промышленное оборудование для осаждения диэлектрических слоев.

7. Физические основы оптической литографии.

Формирование «воздушного изображения» топологического рисунка. Контактная фотолитография и ее варианты («жесткий» контакт, «мягкий» контакт, «зазор»). Проекционная фотолитография. Оптическая изображающая система. Дифракция света на элементах оптической маски («фотошаблона»). Проекционные объективы. Получение «воздушного изображения» на «выходном зрачке» проекционного объектива с уменьшением. Параметры проекционных объективов. Числовая апертура (N.A.), разрешающая способность и глубина фокуса. Системы освещения. Когерентность освещения и частичная когерентность. «Внеосевое» и «аннулярное» освещение.

8. Оптические проблемы проекционной литографии.

Оптические аберрации проекционной системы. Дефокусировка. Изофокальная точка изображения. Глубина фокуса. Формирование воздушного изображения проекционными системами «степперов» и «степ-сканеров». Векторная природа света и формирование «воздушного изображения» в поляризованном свете. «Иммерсионная» фотолитография.

9. Формирование изображения в фоторезисте.

«Стоячие волны» и «боковая» (латеральная) засветка фоторезиста. Светопоглощающие («окрашенные») фоторезисты. Нижнее антиотражающее покрытие. Верхнее антиотражающее покрытие. Контрастосусливающие слои. Уравнения и параметры Дилла (Dill). Моделирование процессов литографии.

10. Фоторезисты.

«Обычные» позитивные и негативные фоторезисты. Фотохимические и химические процессы в фоторезистах при экспонировании светом и термообработке после экспонирования. Кинетика экспонирования. Измерение ABC параметров Дилла. Фоторезисты с «химическим усилением». Фотохимические реакции при экспонировании и термообработке фоторезистов с «химическим усилением». Влияние атмосферных молекулярных загрязнений на чувствительность «химически усиленных» фоторезистов. Химические реакции, катализируемые фотогенерируемой кислотой. Диффузия фотокислоты и деблокирование растворения полимерной основы

11. Проявление фоторезистов.

Кинетика проявления. Влияние молекулярно-массового распределения полимерной основы фоторезистов на их чувствительность и кинетику проявления. Влияние температуры и нормальности проявителя на процесс проявления позитивных фоторезистов. Контраст проявления. Угол наклона боковых стенок проявленного рельефа.

12. Контроль и измерение параметров качества проявленного рельефа маски из фоторезиста.

Контроль формы профиля и критических размеров (CD) элементов маски из фоторезиста. Влияние погрешностей фокусировки изображения на форму профиля и CD. Контроль и измерение погрешностей совмещения топологических слоев. Метки (реперы) совмещения. Амплитудные и фазовые метки. Постоянные и послонные метки. Защита меток при нанесении и травлении последующих слоев. «Окно» допусков фотолитографического процесса. Построение матрицы «фокус – доза экспонирования».

13. Способы улучшения разрешающей способности процесса фотолитографии (RET).

Разрешающая способность литографии. Уравнение Рэлея. Оптимизация формы элементов маски. Коррекция эффекта «оптической близости» (Optical proximity correction - OPC). Оптимизация угла падения света на маску. Внеосевое освещение (Off-axis illumination). Добавление фазовой информации к амплитудной информации маски. «Фазосдвигающие маски» - (Phase-Shift Mask – PSM). «Сильный» («альтернатный») фазовый сдвиг. Фазовый конфликт. Двойное экспонирование. «Слабый» («аттенуатный») фазовый сдвиг. Технологические проблемы изготовления OPC и PSM фотошаблонов.

14. Оборудование фотолитографии.

«Трековые линии» для подготовки поверхности, нанесения, термообработки и проявления фоторезиста. Кластерные комплексы автоматизированных «трековых линий» и установок совмещения и экспонирования. Контактные установки совмещения и экспонирования. Совмещение и экспонирование «на зазоре» (Proximity). Установки проекционного совмещения и экспонирования с мультипликацией («степперы»). Проекционное экспонирование со сканированием изображения («сканеры»). Установки комбинированного экспонирования с мультипликацией и сканированием изображения («степ-сканеры»). Иммерсионные системы.

15. Техничко-экономические показатели фотолитографического оборудования и производства.

Среднее время наработки на отказ (MTBF) и на оперативное вмешательство («помощь» - МТВА). Показатель загрузки оборудования (Utilization). Себестоимость фотолитографического производства (Cost of ownership – COO). Срок окупаемости капитальных затрат.

16. Особенности ионной имплантации и ее применение в технологии микроэлектроники.

Физические основы ИИ. Схематический маршрут формирования активной структуры ИС с использованием ИИ. Достоинства и недостатки использования ИИ в технологическом маршруте изготовления ИС. Методы контроля имплантированных слоев.

5. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)

Необходимое оборудование для лекций и практических занятий: учебная аудитория, оснащенная компьютером и мультимедийным оборудованием (проектор, звуковая система).

Обеспечение самостоятельной работы: доступ в сеть Интернет, доступ к рекомендованной литературе.

6. Перечень рекомендуемой литературы

Основная литература

1. Основы микроэлектроники [Текст] : [учеб. пособие для вузов] / И. П. Степаненко .— 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Лаборатория Базовых Знаний, 2004 .— 488с.
2. Берлин Е.В., Сейдман Л.А., Ионно-плазменные процессы в тонкопленочной технологии , Техносфера Москва. 2010. 527 стр.
3. Оптические технологии микро- и нанoeлектроники, Я.И. Точицкий, 2010, Минск, РИВШ.
4. Г.Я.Красников. Конструктивно-технологические особенности субмикронных МОП-транзисторов. Изд. «Техносфера» Москва 2011.

Дополнительная литература

1. Нанoeлектроника [Текст] : учеб. пособие для вузов / А. А. Щука ; под ред. А. С. Сигова .— 2-е изд. — М. : БИНОМ. Лаб. знаний, 2012 .— 342 с.
2. В.Л.Евдокимов. Закономерности формирования профиля слоев, осаждаемых из газовой фазы. Материалы 7-й отраслевой конференции МЭП «Тонкие пленки в производстве полупроводниковых приборов и интегральных схем» октябрь, 1990 г., стр 127.

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения дисциплины (модуля)

<http://people.rit.edu/lffeee>

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень необходимого программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)

На лекционных и семинарских занятиях используются мультимедийные технологии, включая демонстрацию презентаций.

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

Студент, прослушавший курс лекций и семинаров, должен овладеть общим понятийным аппаратом и научиться применять теоретические знания на практике.

Успешное освоение курса требует:

- 1) посещения всех лекций, предусмотренных учебным планом; ведение конспектов занятий; активное участие в обсуждении лекций и семинаров;
- 2) важно добиться понимания изучаемого материала, а не механического его запоминания. При затруднении изучения отдельных тем, вопросов, следует обращаться за консультацией к преподавателю на лекции или докладчику на семинаре.

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

| | |
|---|---|
| по направлению: | Прикладные математика и физика |
| профиль подготовки: | Физика перспективных технологий: электроника и квантовые технологии Физтех-школа Электроники, Фотоники и Молекулярной Физики кафедра микро- и нанoeлектроники |
| курс: | <u>1</u> |
| квалификация: | магистр |
| Семестр, формы промежуточной аттестации: 2 (весенний) - Экзамен | |
| Разработчик: | П.В. Игнатов |

1. Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины

| Код и наименование компетенции | Индикаторы достижения компетенции |
|---|--|
| ОПК-3 Способен выбирать и (или) разрабатывать подходы к решению типовых и новых задач в области профессиональной деятельности, учитывая особенности и ограничения различных методов решения | ОПК-3.3 Владеет аналитическими и вычислительными методами решения, понимает и учитывает на практике границы применимости получаемых решений |
| | ОПК-3.1 Способен анализировать задачу, планировать пути решения, предлагать и комбинировать способы решения |
| ПК-1 Способен ставить, формализовывать и решать задачи, в том числе разрабатывать и исследовать математические модели изучаемых явлений и процессов, системно анализировать научные проблемы, получать новые научные результаты | ПК-1.1 Способен находить, анализировать и обобщать информацию об актуальных результатах исследований в рамках тематической области своей профессиональной деятельности |
| | ПК-1.2 Способен выдвигать гипотезы, строить математические модели для описания изучаемых явлений и процессов, оценивать качество разработанной модели |
| | ПК-1.3 Способен применять теоретические и (или) экспериментальные методы исследований к конкретной научной задаче и интерпретировать полученные результаты |

2. Показатели оценивания компетенций

В результате изучения дисциплины «Интеграция технологических процессов микро и нанoeлектроники» обучающийся должен:

знать:

- физические и химические основы технологических операций в микро и нанoeлектронике;
- физические параметры характеризующие технологические операции;
- технические и физические основы конструктивного исполнения технологического оборудования;
- влияние физических параметров технологических операций на параметры физической структуры элементной базы и изделий в целом в микро и нанoeлектронике.

уметь:

- разрабатывать основные режимы технологических операций. Разрабатывать технологические процессы;
- проводить анализ влияния физических параметров технологических операций на параметры физической структуры изделий микро и нанoeлектроники;
- применять статистические методы анализа для оценки качества проведения технологических процессов;
- планировать и проводить эксперименты при разработке технологических процессов микро и нанoeлектроники.

владеть:

- первичными навыками разработки технологических операций и технологических процессов микро и нано электроники;
- первичными навыками работы на технологическом оборудовании;
- основными методами анализа оценки качества технологических операций и технологических процессов;
- основными методами проведения экспериментов при разработке технологических процессов микро и нанoeлектроники.

3. Перечень типовых (примерных) вопросов, заданий, тем для подготовки к текущему контролю

С целью контроля освоения обучающимися учебного материала проводится устный опрос в начале занятия по теме прошлой лекции или в конце занятия по пройденной теме.

4. Перечень типовых (примерных) вопросов и тем для проведения промежуточной аттестации обучающихся

Вопросы к экзамену:

1. Процессы ЖХО в маршруте изготовления ИМС.
2. Различные стратегии проведения жидкостных очисток пластин и удаления конкретных загрязнений.
3. Удаление полимерных остатков после проведения процессов плазмохимического травления.
4. Обзор оборудования для процессов ЖХО.
5. Диэлектрические слои в технологии УБИС
6. Физические основы оптической литографии.
7. Оптические проблемы проекционной литографии.
8. Формирование изображения в фоторезисте.

Примеры экзаменационных билетов.

Пример 1.

1. Различные стратегии проведения жидкостных очисток пластин и удаления конкретных загрязнений.
2. Оптические проблемы проекционной литографии.

Пример 2.

1. Удаление полимерных остатков после проведения процессов плазмохимического травления.
2. Физические основы оптической литографии.

Критерии оценивания

10 баллов — (ПРЕВОСХОДНО):

- систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам учебной программы, а также по основным вопросам, выходящим за ее пределы;
- точное использование научной терминологии (в том числе на иностранном языке), стилистически грамотное, логически правильное изложение ответа на вопросы;
- безупречное владение инструментарием учебной дисциплины, умение его эффективно использовать в постановке и решении научных и профессиональных задач;
- выраженная способность самостоятельно и творчески решать сложные проблемы в нестандартной ситуации;
- полное и глубокое усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной учебной программой дисциплины;
- умение ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях по изучаемой дисциплине и давать им критическую оценку, использовать научные достижения других дисциплин;
- творческая самостоятельная работа на практических, лабораторных занятиях, активное участие в групповых обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения заданий.

9 баллов — (ОТЛИЧНО):

- систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам учебной программы;
- точное использование научной терминологии (в том числе на иностранном языке), стилистически грамотное, логически правильное изложение ответа на вопросы;
- владение инструментарием учебной дисциплины, умение его эффективно использовать в постановке и решении научных и профессиональных задач;
- способность самостоятельно и творчески решать сложные проблемы в нестандартной ситуации в рамках учебной программы, полное усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной учебной программой дисциплины;
- умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях по изучаемой дисциплине и давать им критическую оценку;
- самостоятельная работа на практических, лабораторных занятиях, творческое участие в групповых обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения заданий.

8 баллов — (ПОЧТИ ОТЛИЧНО):

- систематизированные, глубокие и полные знания по всем поставленным вопросам в объеме учебной программы;
- использование научной терминологии, стилистически грамотное, логически правильное изложение ответа на вопросы, умение делать обоснованные выводы;
- владение инструментарием учебной дисциплины (методами комплексного анализа, техникой информационных технологий), умение его использовать в постановке и решении научных и профессиональных задач; способность самостоятельно решать сложные проблемы в рамках учебной программы;
- усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной учебной программой дисциплины;
- умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях по изучаемой дисциплине и давать им критическую оценку с позиций государственной идеологии (по дисциплинам социально-гуманитарного цикла);
- активная самостоятельная работа на практических, лабораторных занятиях, систематическое участие в групповых обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения заданий.

7 баллов — (ОЧЕНЬ ХОРОШО):

- систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам учебной программы;
- использование научной терминологии (в том числе на иностранном языке), лингвистически и логически правильное изложение ответа на вопросы, умение делать обоснованные выводы;
- владение инструментарием учебной дисциплины, умение его использовать в постановке и решении научных и профессиональных задач;
- усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной учебной программой дисциплины;
- умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях по изучаемой дисциплине и давать им критическую оценку;
- самостоятельная работа на практических, лабораторных занятиях, участие в групповых обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения заданий.

6 баллов — (ХОРОШО):

- достаточно полные и систематизированные знания в объеме учебной программы;
- использование необходимой научной терминологии, стилистически грамотное, логически правильное изложение ответа на вопросы, умение делать обоснованные выводы;
- владение инструментарием учебной дисциплины, умение его использовать в решении учебных и профессиональных задач; способность самостоятельно применять типовые решения в рамках учебной программы;
- усвоение основной литературы, рекомендованной учебной программой дисциплины;
- умение ориентироваться в базовых теориях, концепциях и направлениях по изучаемой дисциплине и давать им сравнительную оценку; активная самостоятельная работа на практических, лабораторных занятиях, периодическое участие в групповых обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения заданий.

5 баллов — (ПОЧТИ ХОРОШО):

- достаточные знания в объеме учебной программы;
- использование научной терминологии, стилистически грамотное, логически правильное изложение ответа на вопросы, умение делать выводы;
- владение инструментарием учебной дисциплины, умение его использовать в решении учебных и профессиональных задач;
- способность самостоятельно применять типовые решения в рамках учебной программы;
- усвоение основной литературы, рекомендованной учебной программой дисциплины;
- умение ориентироваться в базовых теориях, концепциях и направлениях по изучаемой дисциплине и давать им сравнительную оценку;
- самостоятельная работа на практических, лабораторных занятиях, участие в групповых обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения заданий.

4 балла — (УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО), ЗАЧТЕНО:

- достаточный объем знаний в рамках образовательного стандарта;
- усвоение основной литературы, рекомендованной учебной программой дисциплины;
- использование научной терминологии, стилистическое и логическое изложение ответа на вопросы, умение делать выводы без существенных ошибок;

- владение инструментарием учебной дисциплины, умение его использовать в решении стандартных (типовых) задач;
- умение под руководством преподавателя решать стандартные (типовые) задачи;
- умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях по изучаемой дисциплине и давать им оценку;
- работа под руководством преподавателя на практических, лабораторных занятиях, допустимый уровень культуры исполнения заданий.

3 балла — (НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО), НЕЗАЧТЕНО:

- недостаточно полный объем знаний в рамках образовательного стандарта;
- знание части основной литературы, рекомендованной учебной программой дисциплины;
- использование научной терминологии, изложение ответа на вопросы с существенными лингвистическими и логическими ошибками;
- слабое владение инструментарием учебной дисциплины, некомпетентность в решении стандартных (типовых) задач;
- неумение ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях изучаемой дисциплины;
- пассивность на практических и лабораторных занятиях, низкий уровень культуры исполнения заданий.

2 балла — (НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО):

- фрагментарные знания в рамках образовательного стандарта;
- знания отдельных литературных источников, рекомендованных учебной программой дисциплины;
- неумение использовать научную терминологию дисциплины, наличие в ответе грубых стилистических и логических ошибок;
- пассивность на практических и лабораторных занятиях, низкий уровень культуры исполнения заданий.

1 балл — (НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО):

- отсутствие знаний и компетенций в рамках образовательного стандарта или отказ от ответа.

5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

При проведении экзамена обучающемуся предоставляется 30 минут на подготовку. Опрос обучающегося по билету не должен превышать двух астрономических часов в устной и (или) письменной форме.